

# RN8207C 用户手册

Data: 2014-3-12 Rev: 1.1



## 版本更新说明

版本号	修改时间	修改内容
V1.0	2014-3-20	创建
V1.1	2014-8-25	增加内部未开放功能: 三相锰铜表电压相序检测实现方法; 电能寄存器 2A/2C 功能定义更改; 扩展频率测量范围,增加 35H 寄存器; 对 RX 引脚复位功能做补充说明; 修改错误: 2.7 章节关于 Hfconst 寄存器地址的描述错误; 修改一些文字错误;
		廖以 至义于相庆;



# 目录

1	芯片介绍	4
	1.1 芯片特性	4
	1.2 功能简介	4
	1.3 功能框图	5
	1.4 管脚定义	5
	1.5 典型应用	7
2	系统功能	8
	2.1 电源监测	8
	2.2 系统复位	8
	2.3 模数转换	9
	2.4 有功功率	9
	2.5 无功功率	10
	2.6 有效值	10
	2.7 能量计算	11
	2.8 频率测量	12
	2.9 过零检测	12
	2. 10 中断	12
	2. 12 寄存器	13
3	校表方法	27
4	通信接口	28
	4.1 UART 接口信号说明	28
	4.2 UART 多从机通讯	28
	4.3 UART 数据字节格式	29
	4.4 UART 帧格式	29
	4.5 UART 写操作	31
	4.6 UART 读操作	31
	4.7 UART 接口可靠性设计	32
5	电气特性	33
6	芯片封装	35



### 1 芯片介绍

#### 1.1 芯片特性

#### ✓ 计量

- 提供两路 $\Sigma$ - $\triangle$ ADC
- 有功电能误差在 8000:1 动态范围内<0.1%, 支持 IEC62053-22: 2003 标准要求
- 无功电能误差在 8000:1 动态范围内<0.1%, 支持 IEC62053-23: 2003 标准要求
- 提供一路电流和一路电压有效值测量,在 1000:1 动态范围内,有效值误差<0.1%
- 提供一路脉冲频率发生器,可用于对用户自定义功率进行电能量累加积分
- 潜动阈值可调
- 提供反相功率指示
- 提供电压通道频率测量
- 提供电压通道过零检测
- 提供参考基准监测功能
- 不具备无功电能脉冲输出,用于三相锰铜表设计时,由 cpu 读取无功功率值或者无功电能寄存器的值运算并输出无功脉冲,或者将中断口连接到 cpu 由 cpu 输出无功电能脉冲
- 无需过零信号输出,即可通过软件实现三相电压相序检测

#### ✔ 软件校表

- 电表常数(HFConst)可调
- 提供增益和相位校正
- 提供有功、无功、有效值 offset 校正
- 提供小信号校表加速功能
- 提供配置参数自动校验功能
- ✓ 提供 UART 接口,并具备地址片选功能
- ✓ 具有电源监控功能
- ✓ 具备电能寄存器定时冻结功能,可方便 cpu 实现三相合相及分相电能处理。
- ✓ UART 的 RX 输入引脚同时具备管脚复位功能
- ✓ +5V/3.3V 电源供电,功耗典型值为 15mW@5V、8mW@3.3V
- ✓ 内置 1.25V±1% 参考电压,温度系数典型值 5ppm/℃,最大 15ppm/℃
- ✓ 采用 SOP16L 绿色封装

#### 1.2 功能简介

RN8207C 能够测量有功功率、无功功率、有功能量、无功能量,并能提供电流有效值、电压有效值、线频率、过零中断等,可以实现灵活的防窃电方案。

RN8207C 支持全数字的增益、相位和 offset 校正。有功电能脉冲从 PF 管脚输出。无功电



能脉冲可通过中断口经软件处理后输出。

RN8207C 提供串行接口 UART, 固定波特率 4800, 管脚复位与 UART 输入引脚 RX 复用。RN8207C 内部的电源监控电路可以保证上电和断电时芯片的可靠工作。

#### 1.3 功能框图

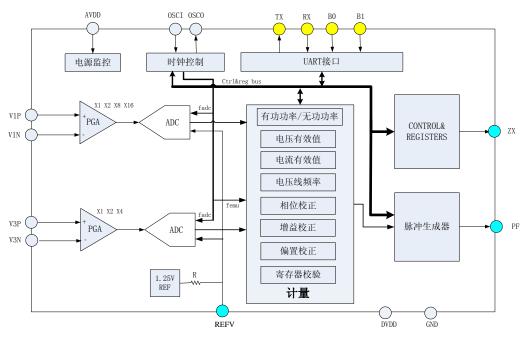
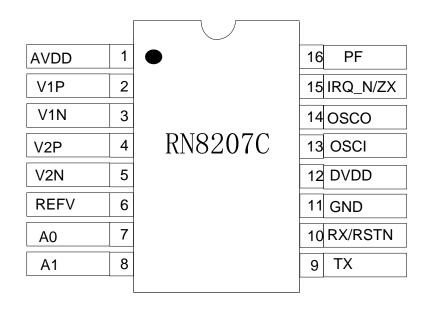


图 1-1 系统框图

#### 1.4 管脚定义





### 图 1-3 RN8207C-SOP16L 管脚排列图

### 表 1-2 RN8207C 管脚功能说明

引脚	标识	特性	功能描述						
1	AVDD	电源	模拟电源引脚。用于给芯片模拟部分供电。该引脚应外接 10μF 电容并联 0.1μF 电容去耦。正常应用范围: 3V-5.5V,选定典型供电电压(如 5V 或 3.3V)后,应保证电源波动在±10%范围内。						
2, 3	V1P, V1N	输入	电流通道的正、负模拟输入引脚。采用完全差分输入方式,正常工作最大输入 Vpp 为±1000mV,最大承受电压为±6V。						
4, 5	V2P, V2N	输入	电压通道的正、负模拟输入引脚。采用完全差分输入方式,正常工作最大输入 Vpp 为±1000mV,最大承受电压为±6V。						
6	REFV	输入/ 输出	1.25V 基准电压的输入、输出引脚。外部基准源可以直接连接到该引脚上。无论使用内部还是外部基准源,该引脚应使用最少 1 µF 电容并联 0.1 µF 电容进行去耦。						
7	A0	输入	串行通信类型和地址选择引脚 A0、A1,用于确定芯片的通信接口类型和地址。内部已有 200K 上拉电阻,外部电路设计需注意。{A1,A0}=11 SPI {A1,A0}=10 UART,地址为 2 {A1,A0}=01 UART,地址为 0						
8	A1	输入							
9	TX	输出	见 A0 说明, <b>内部已有 200K 上拉电阻,外部电路设计需注意。</b> 该引脚为 UART 的数据输出端 TX,默认输出为高电平。						
10	RX/RSTN	输入	该引脚为 UART 输入端 RX,同时也是复位引脚,当输入信号低电平超过 20ms 时 RN8207C 认为是复位有效。 RN8207C 内部复位电路与 UART 通信电路完全独立,该管脚复位功能完全等同独立的管脚复位。						
11	GND	地	芯片地,注意该引脚不应与 DVDD 去耦电容等数字噪声大的接地点直接连接,而是应尽量距离远一些。						
12	DVDD	电源	数字电源引脚。用于给芯片数字部分供电。该引脚应外接 10μF 电容并联 0.1μF 电容去耦。正常应用范围: 3V-5.5V,选定典型供电电压(如 5V 或 3.3V)后,应保证电源波动在±10%范围内。						
13	OSCI	输入	外部晶体的输入端,或是外灌系统时钟输入。晶体频率典型值为3.579545MHz。外接电容典型值为15pF或22pF,内部已有约4M欧姆的跨接电阻,外部不需要加跨接电阻。要求外部晶体的ESR小于50欧姆。						
14	OSCO	输出	外部晶体的输出端。						
15	IRQ_N /ZX	输出	中断/过零检测输出管脚,复位后,为中断管脚。 Zxcfg=0(EMUCON-bit7)时作为中断请求 IRQ_N; Zxcfg=1(EMUCON -bit7)时作为 ZX: 电压通道过零输出。						
16	PF	输出	有功电能校验脉冲输出,默认状态低电平输出。其频率反映瞬时有 功功率的大小。具有 5mA 的输出和吸电流能力。						



### 1.5 典型应用

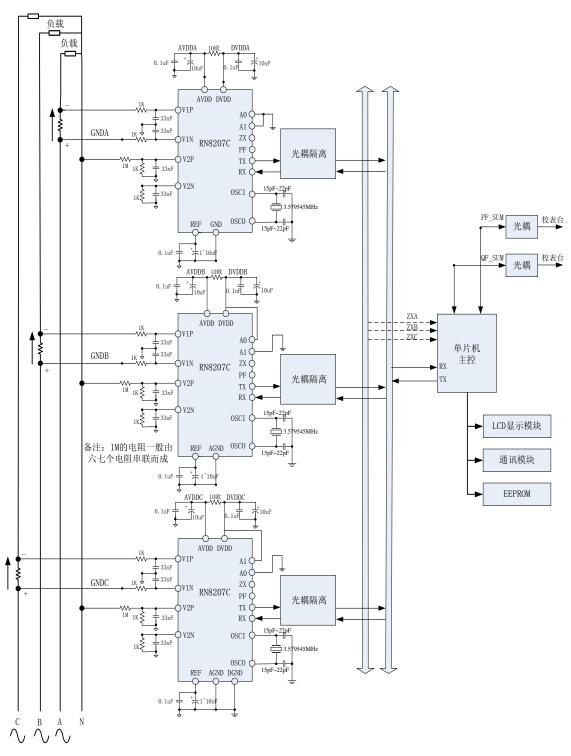


图 1-4 RN8207C 三相锰铜表典型应用

(备注: 无需过零信号 ZX 输出,即可实现三相电压相序检测功能)



### 2 系统功能

#### 2.1 电源监测

RN8207C 片内包含一个电源监测电路,连续对模拟电源(AVDD)进行监控。当电源电压低于 2.6V±0.1V 时芯片被复位,当电源电压高于 2.75V±0.1V 时芯片正常工作。

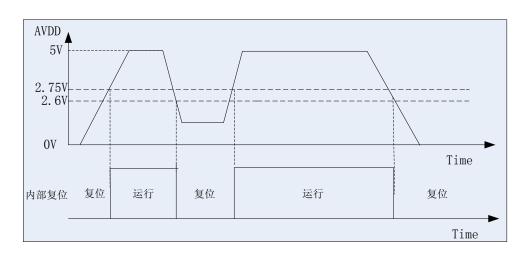


图 2-1 电源检测特性

正常应用范围: 3V-5.5V,选定典型供电电压(如 5V 或 3.3V)后,应保证电源波动在±10%范围内。

#### 2.2 系统复位

RN8207C 支持三种全局复位方式:

- 上下电
- RX 引脚复位
- 命令复位

任一全局复位发生时,寄存器恢复到复位初值,外部引脚电平恢复到初始状态。 命令复位之后 15us, 芯片完成复位。

RN8207C 的 RX 引脚同时也是复位引脚,当输入信号低电平超过 20ms 时 RN8207C 认为是复位有效。此功能可在隔离应用情况下可节省光耦数量。RN8207C 内部复位电路与UART 通信电路完全独立,该管脚复位功能完全等同独立的管脚复位。

建议的 RX 引脚软件复位操作方式是: 先将 RX 引脚置低 25ms, 然后再将 RX 引脚置高 20ms, 最后再开始正常的 UART 通信。相关寄存器:

系统状态寄存器中的 RST 是复位标志: 当外部 RST\_N 引脚或者上电复位结束时,该位



置 1,读后清零。可用于复位后校表数据请求。

建议 CPU 在初始化计量芯片前使用 RX 引脚复位或者命令复位对计量芯片进行一次复位操作。

#### 2.3 模数转换

RN8207C 包括两路 ADC, 一路用于相线电流采样, 一路用于电压采样。

ADC 采用全差分方式输入,电流、电压通道最大信号输入幅度为峰值 1000mv。

通过配置系统控制寄存器(SYSCON 0x00H)中的 bit5~bit0 位,可以分别对两路 ADC 配置放大倍数,电流通道的 ADC 放大倍数 4 档可选: 1、2、8、16; 电压通道 ADC 放大倍数 3 档可选: 1、2、4。电流通道的增益放大倍数默认为 16 倍。

#### 2.4 有功功率

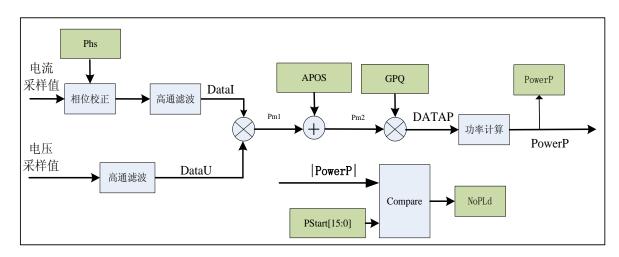


图 2-2 有功功率框图

RN8207C 提供有功功率的计算和校正,相关寄存器包括相位校正、有功 Offset 校正、有功增益校正和平均功率寄存器。

平均功率 PowerP 还用于判断潜动和启动。启动阈值可以通过 PStart 寄存器配置。

图中的数字高通滤波器主要是用于去除电流、电压采样数据中的直流分量。

图中的 DCI、DCU 用于对 ADC 通道的直流偏置进行校正,RN8207C 用于直流测量应用时,需要对直流偏置进行校正,同时需要将高通滤波器关闭。



#### 2.5 无功功率

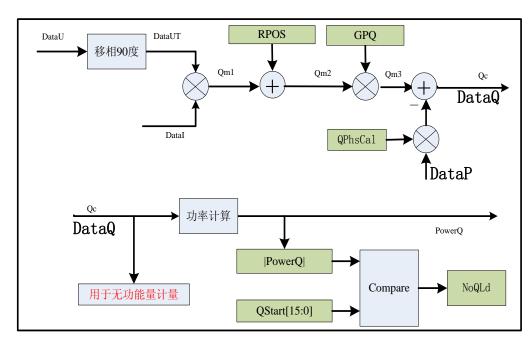


图 2-3 无功功率框图

RN8207C 包含无功功率计量电路。其中用于计量的 DataUT 是 DataU 移相 90 度的结果; 平均无功功率 PowerQ 还用于判断启动和潜动,启动阈值可以通过 QStart 寄存器配置。

#### 2.6 有效值

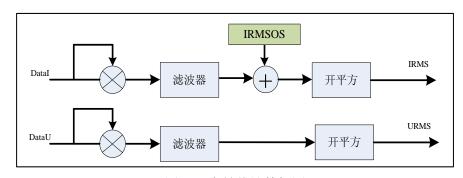


图 2-3 有效值计算框图

RN8207C 提供两个通道的真有效值参数输出,包括 URMS、IRMS。字长为 24bit,每 3.495HZ 或 13.982Hz 更新一次。此外还包括有效值 Offset 寄存器: IRMSOS。



#### 2.7 能量计算

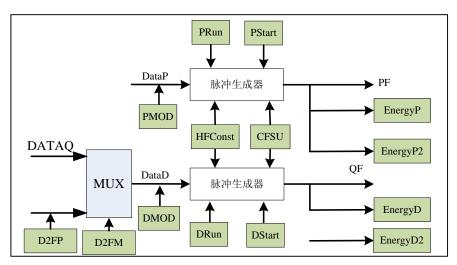


图 2-4 能量计算

#### 能量脉冲输出:

脉冲输出,也即校表脉冲输出,可以直接接到标准电能表进行误差比对。 PF/QF 输出满足下面时序关系:

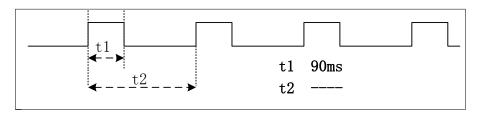


图 2-5 输出脉冲宽度

注意: 当脉冲输出周期小于 180ms 时, 脉冲以等 duty 形式输出。

#### PFcnt/DFcnt、HFConst、脉冲输出、能量寄存器的关系:

当 2\*|PFcnt| (0x20H)=HFConst (0x02H)时,PF有一个脉冲输出。同时能量寄存器 EnergyP (0x29H)和 EnergyP2 (0x2AH)加 1。

当 2\*|DFcnt| (0x21H)=HFConst (0x02H)时, QF 有一个脉冲输出。同时能量寄存器 EnergyD (0x2BH)和 EnergyD2 (0x2CH)加 1。

#### 脉冲输出、能量寄存器和 PRun/DRun 以及 PStart/DStart 的关系:

有功/自定义能量寄存器和 PF/QF 输出还受到 PRun/DRun 以及 PStart/DStart 的控制。

- 当 PRun=0 或者|P|小于 PStart 时, PF 不输出脉冲, PFcnt 和有功能量寄存器不增加。
- 当 DRun=0 或者|DataD|小于 DStart 时,QF 不输出脉冲,DFcnt 和自定义能量寄存器不增加。

#### 自定义脉冲输出:

DataD 的来源默认是 DATAQ(无功功率),也可以选择为 D2FP(用户写入),通过 D2FM 寄存器来选择具体使用哪个功率。

#### 脉冲输出加速:

为加快小信号校正速度,提供脉冲输出加速功能。在小信号校正时可以配置 EMUCON



(0x01H)寄存器的 **CFSUEN** 和 **CFSU[1:0]**位,使 PF/QF 的输出频率提高,最快可以提高 16 倍。 **反向指示:** 

当有功或自定义功率为负时, EMUStatus 寄存器的 REVP 位或 REVQ 位会变为 1, REVP 位与 PF 脉冲同步更新, REVO 位与 OF 脉冲同步更新。

#### 2.8 频率测量

RN8207C 可以直接输出线频率参数(UFreq 0x25H 2 字节),测量基波频率,最小测量频率为 6.8Hz,测量带宽 250Hz。

RN8207C 同时提供另外一个线频率参数寄存器(UFreq2 0x35 3 字节),测量基波频率,最小测量频率为1Hz,测量带宽250Hz。

#### 2.9 过零检测

RN8207C 通过配置 ZXCFG(EMUCON.7)选择引脚 IRQ\_N/ZX 开启/关闭过零输出。 RN8207C 通过配置 ZXD1(EMUCON.9)、ZXD0(EMUCON.8)寄存器位选择四种过零输出方式。

当软件使用过零测量特殊命令(0xEA/0x&7C,见 2.12.6 章节)时,计量芯片将收到该命令的时刻作为时间基准,测量出电压过零与该时间基准的时间差,时间差保存在 ZXCNT(0x34H)寄存器。当用户使用三个 RN8207C 设计三相表时,通过 UART 的广播命令发送过零测量特殊命令,三个 RN827C 收到命令后同时启动测量,软件根据三个 RN8207C 测量值可实现三相电压相序的判断。

#### 2.10 中断

RN8207C 中断资源包括 1 个中断允许寄存器 IE、2 个中断状态寄存器 IF 和 RIF、一个复用的中断请求管脚 IRO N/ZX。其中 RIF 同 IF,读 RIF 可清 IF,读 IF 也可清 RIF。

#### 1. 中断请求信号 IRQ\_N

IRQ\_N/ZX 引脚为 IRQ\_N 和过零检测输出 ZX 复用,通过配置 EMUCON 寄存器(0x01H)的 ZXCFG 位确定该引脚的用途。

当中断允许寄存器相应的中断允许位使能且中断事件发生时,IRQ\_N 引脚为低电平。当 CPU 通过 SPI 接口读 RIF 或 IF,在发完命令字节最后一个比特(LSB)的 SCLK 下降沿,IRQ\_N 引脚恢复为高电平。

#### 2. 中断处理过程

#### 硬件:

- RN8207C 的 IRQ\_N 通常和 MCU 的外部中断管脚/INT 相连,当 IRQ\_N 由高变低时 MCU 产生/INT 中断。
- MCU 作为 UART 主机, RN8207C 作为 UART 从机。

#### 中断处理程序:

步骤一: MCU 中断初始化

- 1. MCU 读 RN8207C RIF, 清 IF 和 RIF 中断标志;
- 2. 配置 RN8207C IE 寄存器, 使能需要的中断允许位以产生 IRQ N;



3.MCU 使能/INT 外部中断,等待 RN8207C 中断事件发生, IRQ\_N 输出触发/INT 中断, 跳入/INT 的中断入口地址。

#### 步骤二: MCU 中断服务程序

- 1. 关闭 MCU 全局中断和/INT 中断:
- 2. MCU 通过 SPI 读 RIF 寄存器,清 IF和 RIF 寄存器,将 IRQ\_N 恢复到高电平。
- 3. MCU 通过判断 RIF 的中断标志来判断 RN8207C 的中断源,转而执行相应的中断处理程序。
- 4. 执行完中断处理程序,MCU 打开全局中断和/INT 中断,并恢复现场后中断返回。

中断返回后,若检测到/INT 中断标志,程序又进入到外部中断 ISR 中,重复 2。若未检测到/INT 中断标志,说明中断处理过程中未发生中断事件,程序继续运行。

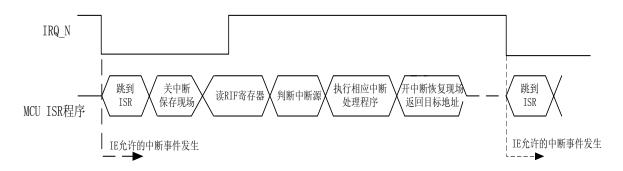


图 2-6 RN8207C 中断处理过程

#### 2.12 寄存器

#### 2.12.1 寄存器列表

表 2-3 RN8207C 寄存器列表

ایا بایا	わわ	D/W		有片店	
地址	名称	R/W	字长	复位值	功能描述
			校表	長参数和计量控	空制寄存器
00H	SYSCON	R/W	2	0003h	系统控制寄存器,写保护
01H	EMUCON	R/W	2	0003h	计量控制寄存器,写保护
02H	HFConst	R/W	2	1000h	脉冲频率寄存器,写保护
03H	PStart	R/W	2	0060h	有功起动功率设置,写保护
04H	DStart	R/W	2	0120h	自定义电能起动功率设置,写保护
05H	GPQ	R/W	2	0000h	功率增益校正寄存器,写保护
06H	保留	R/W	2	0000h	只读,不可写
07H	Phs	R/W	1	00h	相位校正寄存器,写保护
08H	保留	R/W	1	00h	只读, 不可写
09H	QPhsCal	R/W	2	0000h	无功相位补偿,写保护
0AH	APOS	R/W	2	0000h	有功功率Offset校正寄存器,写保护
0BH	保留	R/W	2	0000h	只读,不可写
0CH	RPOS	R/W	2	0000h	无功功率Offset校正寄存器,写保护
0DH	保留	R/W	2	0000h	只读, 不可写
0EH	IRMSOS	R/W	2	0000h	电流有效值Offset补偿,写保护



0FH	保留	R/W	2	0000h	只读,不可写
10H	保留	R/W	2	0000h	只读,不可写
11H	D2FPL	R/W	2	0000h	自定义功率寄存器D2FP的低16bit,写保护
12H	D2FPH	R/W	2	0000h	自定义功率寄存器D2FP的高16bit,用户 需要先写D2FPH,再写D2FPL,然后D2FP
			_		才进行电能积分,写保护。
13H	DCIH	R/W	2	0000h	I通道直流offset校正寄存器的高16bit,写保护
14H	保留	R/W	2	0000h	只读, 不可写
15H	DCUH	R/W	2	0000h	U通道直流offset校正寄存器的高16bit,写保护
					直流offset校正寄存器的低4bit:
16H	DCL	R/W	2	0000h	DCL[11:0]={DCU[3:0],4'H0,DCIL[3:0]} ,
					写保护
17H	EMUCON2	R/W	2	0000h	计量控制寄存器2,写保护
		•	ì	十量参数和状态	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
20H	PFCnt	R/W	2	0000h	快速有功脉冲计数,写保护
21H	DFcnt	R/W	2	0000h	自定义电能快速脉冲计数,写保护
22H	IRMS	R	3	000000h	电流有效值
23H	保留	R	3	000000h	只读, 保留位
24H	URMS	R	3	000000h	电压有效值
25H	UFreq	R	2	0000h	电压频率
26H	PowerP	R	4	00000000h	有功功率
27H	保留	R	4	00000000h	只读,保留位
28H	PowerQ	R	4	00000000h	无功功率
29H	EnergyP	R	3	000000h	有功能量,读后清零、不清零可选,默认 为读后不清零
2AH	EnergyP2	R	3	000000h	有功能量读后不清零寄存器或有功能量 冻结寄存器
2BH	EnergyD	R	3	000000h	自定义能量,读后清零、不清零可选,默 认为读后不清零
2CH	EnergyD2	R	3	000000h	自定义能量读后不清零寄存器或能量冻 结寄存器
2DH	EMUStatus	R	3	00EE79h	计量状态及校验和寄存器
30H	SPL_I	R	3	000000h	I通道ADC采样值,24位,二进制补码格式
31H	保留	R	3	000000h	只读, 保留位
32H	SPL_U	R	3	000000h	U通道ADC采样值,24位,二进制补码格式
34H	ZXCNT	R	2	0000h	电压过零计数寄存器
35H	UFreq2	R	3	000000h	电压频率寄存器2,扩展了测频范围,50Hz 时读出值同UFreq(0x25H)
	<u> </u>	<u> </u>	<u>l</u>	中断寄存	1, ,
40H	IE	R/W	1	00h	中断允许寄存器,写保护
41H	IF	R	1	00h	中断标志寄存器,读后清零
	ı	L			



42H	RIF	R	1	00h	复位中断状态寄存器,读后清零	
系统状态寄存器						
43H	SysStatus	R	1		系统状态寄存器	
44H	RData	R	4		上一次UART读出的数据	
45H	WData	R	2		上一次UART写入的数据	
7FH	DeviceID	R	3	820700h	RN8207C Device ID	

#### 2.12.2 校表参数寄存器

#### 系统控制寄存器 SYSCON(0x00)

SYSTE	M Control Regi	ster (SYSC	ON) Add	ress: 0x00 H	Default Value: 0003H			
位	位名称			功能描述				
15	保留	默认为 0, 7	默认为 0,不要对该位写 1					
					h16, 表示当前波特率为 4800			
14-8	Uartbr[6:0]	请注意: ua 率。	rtbr[6:0]参 <sup>_1</sup>	<b>ラ校验和计算</b> 。	RN8207C 固定为 4800 波特			
7	保留	默认为 0, 7	不要对该位写	<b></b>				
6	保留	默认为 0, 7	不要对该位写	<b></b>				
5-4	保留	默认为 0, 7	不要对该位写	<b></b>				
3-2	PGAU[1:0]	电压通道模 PGAU1 0 0 1 1	拟增益选择: PGAU0 0 1 0 1	电压通道 PGA=1 PGA=2 PGA=4 PGA=4				
1-0	PGAI[1:0]	电流通道模 PGAI1 0 0 1	拟增益选择 PGAI0 0 1 0	,默认值为 16 电流通道 PGA=1 PGA=2 PGA=8	倍。			

#### 计量控制寄存器

计量控制寄存器用于计量功能的设置。

Energy	Measure Contr	rol Register (EMUCON) Address: 0x01 H Default Value: 0003H
位	位名称	功能描述
15	EnergyCLR	默认为 0 =0: 电能寄存器为累加型; =1: 电能寄存器为读后清零型;



14	保留	默认为 0,7	下要对该位写	1			
		自定义能量	累加方式选择	:			
		QMOD1	QMOD0	累加功率 Qm			
		0	0	Qm=DataQ, 正反向功率都参与累加,			
13-12	QMOD[1:0]			负功率有 REVQ 符号指示。			
13-12	QMOD[1.0]	0	1	只累加正向功率			
		1	0	Qm= DataQ ,正反向功率都参与累加,			
				无负功率符号指示。			
		1	1	Qm=DataQ(保留)			
11-10	PMOD[1:0]			同上表自定义能量累加方式。			
				居 ZXD1 和 ZXD0 的配置输出不同的波形:			
9	ZXD1			的过零点处 ZX 输出发生变化;			
		ZXD1=1,表示在正向和负向过零点处 ZX 输出均发生变化。					
8	ZXD0	ZXD0=0,表示选择正向过零点作为过零检测信号;					
		ZXD0=1,表示选择负向过零点作为过零检测信号。					
7	ZXCFG			/ZX 作为 IRQ_N。			
		ZXCFG =1: 引脚 IRQ_N /ZX 作为 ZX。					
6	HPFIOFF			数字高通滤波器			
				数字高通滤波器			
5	HPFUOFF			道数字高通滤波器			
				道数字高通滤波器	п.Э.		
	CECLIEN		_	向出加速模块的控制位,CFSUEN=1,使能			
4	CFSUEN	冲加速模块,脉冲的输出速率提高 2^(CFSU[1:0]+1)倍。CFSUEN=0, 关闭脉冲加速模块,脉冲正常输出。					
3,2	CECUI1.01			'止吊制出。 月。见 CFSUEN 说明。			
3,2	CFSU[1:0]						
1	DRUN		-	输出和自定义电能寄存器累加; 输出和自定义电能寄存器累加。默认状态	<b>4</b> -		
1	DRUN	1.	てい」 <b>Qr</b> MY中	他山地日足 <b>义</b> 电配可行奋系加。	Ŋ		
			# AF DE Hiv \hd	输出和有功电能寄存器累加 <b>:</b>			
0	PRUN	_			1		
		PRUN=0,关闭 PF 脉冲输出和有功电能寄存器累加。默认状态为 1。					

### 脉冲频率寄存器

High Frequency Impulse Const Register (HFConst)				Address:	Address: 0x 02H Default Value : 1000H			
	Bit15	14	13	12	11	10	9	Bit8
Read:	TIPO15	HEC14	HEG12	IIPC12	IJEC11	IIIC10	HEGO	HEGO
Write:	HFC15	HFC14	HFC13	HFC12	HFC11	HFC10	HFC9	HFC8
Reset:	0	0	0	1	0	0	0	0
:	Bit7	6	5	4	3	2	1	Bit0
Read	HEG7	HECK	HEGS	HEC4	HEGS	HEGO	HECI	HECO
Write:	HFC7	HFC6	HFC5	HFC4	HFC3	HFC2	HFC1	HFC0



HFConst 是 16 位无符号数,做比较时,将其与快速脉冲计数寄存器 PFCNT/DFCNT 寄存器值的绝对值的 2 倍做比较,如果大于等于 HFConst 的值,那么就会有对应的 PF/QF 脉冲输出。

#### 潜动与启动阈值寄存器

Start Pow	er Threshold Se	etup Register (	PStart)	Address: 0x 03h Default Value : 0060H				
	Bit15	14	13	12	11	10	9	Bit8
Read:	DC15	DC 14	DC 12	DC 12	DC11	DC10	DC 0	DC 0
Write:	PS15	PS 14	PS 13	PS 12	PS11	PS10	PS 9	PS 8
Reset:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bit7	6	5	4	3	2	1	Bit0
Read:	PGZ	DG 6	DG 5	DG 4	DG 2	DG 2	DG 1	DG 0
Write:	PS7	PS 6	PS 5	PS 4	PS 3	PS 2	PS 1	PS 0
Reset:	0	1	1	0	0	0	0	0

Start Pow	er Threshold So	etup Register (	DStart)	Address: 0x	k 04h Default V	/alue : 0120H		
	Bit15	14	13	12	11	10	9	Bit8
Read:	0015	00.14	00.12	00.12	0011	0010	0.20	00.0
Write:	QS15	QS 14	QS 13	QS 12	QS11	QS10	QS 9	QS 8
Reset:	0	0	0	0	0	0	0	1
	Bit7	6	5	4	3	2	1	Bit0
Read:	0.05	00.5	00.5	00.4	00.0	00.2	00.1	00.0
Write:	QS7	QS 6	QS 5	QS 4	QS 3	QS 2	QS 1	QS 0
Reset:	0	0	1	0	0	0	0	0

启动阈值可由 PStart 和 DStart 寄存器配置。它们是 16 位无符号数,做比较时,将其分别与 PowerP 和 DataD (为 32bit 有符号数)的高 24 位的绝对值进行比较,以作起动判断。

|PowerP|小于 PStart 时, PF 不输出脉冲。

|DataD|小于 DStart 时,QF 不输出脉冲。

#### 增益校正寄存器

Power Gain Register A(GPQ)		Address: 0x0	5h Default Value : 0000H				
	Bit15	14	13	12 3	2	1	Bit0
Read:	CDO 15	CDO 14	CDO 12	CDO 12 CDO 2	CDO 2	CDO 1	CPO 0
Write:	GPQ_15	GPQ_14	GPQ_13	GPQ_12GPQ_3	GPQ_2	GPQ_1	GPQ_0
Reset:	0	0	0	0	0	0	0

该寄存器为二进制补码格式,最高位为符号位。

校正公式为: P1=P0(1+GPQS)

Q1=Q0(1+GPQS)



其中 GPOS 为增益校正寄存器的归一化值。使用方法见第三章校表方法。

#### 相位校正寄存器

Phase Calibration Register (Phs)			Address: 0x 0	7H Default V	alue : 00H				
	Bit7	6	5	5 4 3 2 1 Bit0					
Read:	DL. 7	Dl. C	Die 5	Di 4	Dis. 2	Dis. 2	Di 1	Dis. 0	
Write:	Phs_7	Phs_6	Phs _5	Phs _4	Phs _3	Phs _2	Phs _1	Phs _0	
Reset:	0	0	0	0	0	0	0	0	

该寄存器为带符号二进制补码,Bit0~bit7 有效,其中 bit7 为符号位。使用方法见第三章校表方法。

1 LSB 代表 1/895khz=1.12us/LSB 的延时,在 50HZ 下,1 LSB 代表 1.12 us\*360°\*50/10^6=0.02° /LSB 相位校正。

相位校正范围: 50HZ 下, ±2.56°

请注意: 计量控制寄存器 2(EMUCON2 地址: 0x17H)新增寄存器位,可将相位校正 刻度提升至  $0.01^{\circ}$ 

#### 无功相位补偿寄存器

Reactive 1	Reactive Power Phase Calibration Register (QPhsCal)			Address: 09H Default Value : 0000H				
	Bit15	14	13	123		2	1	Bit0
Read:	ODC15	ODC14	OPC12	OPCI	a opca	ODCA	ODCI	OPCO
Write:	QPC15	QPC14	QPC13	QPC1.	2 QPC3	QPC2	QPC1	QPC0
Reset:	0	0	0	0	0	0	0	0

无功相位补偿寄存器用于 U 通道 90°移相滤波器在无功计算中的相位补偿。无功相位补偿寄存器采用十六位二进制补码形式,最高位为符号位。使用方法见第三章校表方法。

校正公式: Q2 = Q1-QPhs\*P1

其中 P1 为有功功率, Q1 为补偿前的无功功率, Q2 为补偿后的无功功率。

#### 有功 Offset 校正寄存器

Active Power Offset Register (APOS)		Address: 0AH	H Default Value : 0000H				
	Bit15	14	13	12 3	2	1	Bit0
Read:	A DOC 15	A DOG 14	ADOC 12	ADOC 12 ADOC 2	ADOC 2	ADOC 1	A DOG O
Write:	APOS_15	APOS _14	APOS _13	APOS _12APOS _3	APOS _2	APOS _1	APOS _0
Reset:	0	0	0	0	0	0	0

有功 OFFSET 校正适合小信号的精度校正。该寄存器为二进制补码格式,最高位为符号位。使用方法见第三章校表方法。

#### 无功 Offset 校正寄存器

Rective Power Offset Register (RPOS)	Address: 0CH	Default Value : 0000H
--------------------------------------	--------------	-----------------------



	Bit15	14	13	12 3	2	1	Bit0
Read:	DDOC 15	PPOC 14	DDOC 12	RPOS 12RPOS 3	DDOG 2	RPOS 1	DDOS 0
Write:	RPOS_15	RPOS _14	RPOS _13	KFOS _12KPOS _5	RPOS _2	KPOS_I	RPOS _0
Reset:	0	0	0	0	0	0	0

无功 Offset 校正寄存器用于无功小信号精度的校正。该寄存器为二进制补码格式,最高位为符号位。使用方法见第三章校表方法。

#### 有效值 Offset 校正寄存器

IRMS Off	set Register(IRM	ISOS)	Address: 0EH	Default Value : 0000H			
	Bit15 14		13	12 3	2	1	Bit0
Read:	TDMG 15 TDMG 14		IDMC 12	IDMC 12 IDMC 2	IDMC 2	IDMC 1	IDMG 0
Write:	IRMS_15	IRMS _14	IRMS _13	IRMS _12IRMS _3	IRMS _2	IRMS _1	IRMS _0
Reset:	0	0	0	0	0	0	0

有效值 Offset 校正寄存器用于电流有效值小信号精度的校正。该寄存器为二进制补码格式,最高位为符号位。使用方法见第三章校表方法。

#### 自定义功率寄存器

自定义功率寄存器是 32 位有符号数,由 D2FPH(0x12H)和 D2FPL(0x11H)共同组成,其中 D2FPH 为高 16bit , D2FPL 为低 16bit。D2FPH 的最高位是符号位。

如 D2FM 寄存器(EMUCON2 的 bit5~4)配置为自定义功率,当用户往自定义功率寄存器写入功率值, RN8207C 会自动按照脉冲常数设置进行积分,积分得到的电能存放在 EnergyD(0x2BH)和 EnergyD2(0x2CH),积分得到的脉冲从 QF 管脚输出。

用户需要先写 D2FPH,再写 D2FPL,然后 D2FP 才生效。

#### 直流偏置校正寄存器

RN8207C 新增两个通道的直流偏置校正寄存器,用于不需要高通滤波器的计量场合。每个通道的直流偏置校正寄存器为 20 位。直流偏置校正的方法见应用笔记。

#### 计量控制寄存器 2

Energy	Measure Conti	rol Register2 (EMUCON2) Address: 0x17 H Default Value: 0000H						
位	位名称	功能描述						
15~10	保留	只读, 不可写						
13,12	FreqCnt	=00:频率测量的时间为 32 个周波; =01:频率测量的时间为 4 个周波; =10:频率测量的时间为 8 个周波; =11:频率测量的时间为 16 个周波;						
11,9	保留	默认为 0						



8	Phs0	可作为最低位与Phs(0x07H)寄存器共同组成一个9位的相位校正寄存器,将相位校正分辨度从 0.02 度提高到 0.01 度。当该寄存器为 0 时,对相位校正不起作用。
7	upmode	=0,功率及有效值寄存器更新速度为 3.495Hz; =1,功率及有效值寄存器更新速度为 13.982Hz;
6	ZXMODE	=0,过零信号输出源为正常计量的电压信号,谐波没有滤除; =1,过零信号输出源为低通滤波后的电压信号。
5,4	D2FM[1:0]	=00:自定义电能输入选择为无功功率; =01:保留; =10:保留; =11:自定义电能输入选择为自定义功率寄存器 D2FP
3	Energy_fz	=0, 电能寄存器 2 作为读后清零型电能寄存器。 =1, 电能寄存器 2 (地址 2A 和 2C) 启用定时冻结功能, 每隔 572.1793 毫秒 (2048 个晶振周期) 将电能寄存器 1 (地址 29 和 2B) 的值装载 到电能寄存器 2, 同时将电能寄存器 1 清零。
2~0	保留	默认为 0, 用户不要操作该寄存器位

#### 2.12.3 计量参数寄存器

#### 快速脉冲计数器

Active Energy Counter Register (PFCNT)			Address: 0x20h				
	Bit15	14	13	12 3	2	1	Bit0
Read:	DEC15	DEC14	DEC12	DEC12 DEC2	DECO	PFC1	DECO.
Write:	PFC15	PFC14	PFC13	PFC12PFC3	PFC2	PFCI	PFC0
Reset:	0	0	0	0	0	0	0

Reactive 1	Reactive Energy Counter Register (DFCNT)			Address: 0x21h	Address: 0x21h				
	Bit15	14	13	12 3	2	1	Bit0		
Read:	OFC15	OFC14	OFC12	OFG12 OFG2	OFCO	OFGI	OFG0		
Write:	QFC15	QFC14	QFC13	QFC12QFC3	QFC2	QFC1	QFC0		
Reset:	0	0	0	0	0	0	0		

为了防止上下电时丢失电能,掉电时 MCU 将寄存器 PFCnt/DFcnt 值读回并进行保存,然后在下次上电时 MCU 将这些值重新写入到 PFCnt/DFcnt 中去。

当快速脉冲计数寄存器 PFCnt/DFcnt 计数值的绝对值的 2 倍大于等于 HFconst 时,相应的 PF/QF 会有脉冲溢出,能量寄存器的值会相应的加 1。

#### 电流电压有效值寄存器

Current A Rms Register (IARms)	Address:	0x22h



	Bit23	22	21	20 3	2	1	Bit0
Read:	IS23	IS22	IS21	IS20IS3	IS2	IS1	IS0

Voltage R	Voltage Rms Register (Urms)		Address:	0x24h			
	Bit23	22	21	20 3	2	1	Bit0
Read:	US23	US22	US21	US20US3	US2	US1	US0

有效值 Rms 是 24 位有符号数,最高位为 0 表示有效数据,最高位为 1 时读数做零处理;参数更新的频率为 3.495Hz 或 13.982Hz 可选。

#### 电压频率寄存器

Voltage F	Voltage Frequency Register (UFreq)		Address:	0x25h			
	Bit15	14	13	12 3	2	1	Bit0
Read:	Ufreq15	Ufreq14	Ufreq13	Ufreq12Ufreq3	Ufreq2	Ufreq1	Ufreq0

主要测量基波频率,测量带宽 250Hz 左右。

频率值是一个16位的无符号数,参数格式化公式为:

#### f=CLKIN/8/UFREO

例如,如果系统时钟为 CLKIN=3.579545MHz,UFREQ=8948,那么测量到的实际频率为: f=3579545/8/8948=49.9908Hz。

电压频率测量值默认更新的周期为 0.64s, 可通过计量控制寄存器 2 调整更新时间。

同时提供 UFreq2 电压频率寄存器 2, 地址为 0x35H, 字长为 3 字节, 测量基波频率, 最小测量频率为 1Hz, 测量带宽 250Hz。输入 50Hz 时读出值同 UFreq(0x25H)

#### 平均有功功率寄存器

Active Po	Active Power Register (PowerP)		Address:	0x26h			
	Bit31	30	29	28 3	2	1	Bit0
Read:	AP23	AP22	AP21	AP20AP3	AP2	AP1	AP0

有功功率参数 PowerP 是二进制补码格式,32 位数据,其中最高位是符号位。功率参数更新的频率为3.495Hz 或13.982Hz 可选。

#### 平均无功功率寄存器

Reactive	Reactive Power Register (PowerQ)		Address:	0x28h			
	Bit31	30	29	28 3	2	1	Bit0
Read:	RP31	RP30	RP29	RP28RP3	RP2	RP1	RP0

无功功率参数 PowerQ 是二进制补码格式,32 位数据,其中最高位是符号位。更新频率同 PowerP。



#### 有功电能寄存器

Active En	Active Energy Register (EnergyP)		Address:	0x29h			
	Bit23	22	21	20 3	2	1	Bit0
Read:	EP23	EP22	EP21	EP20EP3	EP2	EP1	EP0

EnergyP 寄存器是累加型或清零型有功能量寄存器。当选择为累加型时(**EMUCON 寄存器 bit15=0**),在 0xFFFFFF 溢出到 0x0000000 时,会产生溢出标志 POIF(参见 IF 0x41H)。当选择为清零型时(**EMUCON 寄存器 bit15=1**),寄存器读后清为 0.

电能参数是无符号数, EnergyP 的寄存器值分别代表 PF 脉冲的累加个数。寄存器最小单位代表的能量为 1/EC kWh。其中 EC 为电表常数。

#### 有功电能寄存器 2

Active En	Active Energy Register2 (EnergyP2)		Address:	0x2AH				
	Bit23	22	21	20 3	2	1	Bit0	
Read:	EP23_2	EP22_2	EP21_2	EP20_2EP3_2	EP2_2	EP1_2	EP0_2	

当计量控制寄存器 2 的 energy\_fz 位等于 0 时,该寄存器是读后清零型有功电能寄存器;当计量控制寄存器 2 的 energy\_fz 位等于 1 时,该寄存器启用定时冻结功能,每隔 572.1793 毫秒(2048 个晶振周期)将有功电能寄存器(地址 29)的值装载到该寄存器,同时将有功电能寄存器清零。

#### 自定义电能寄存器

UserDEII	FNE Energy	y Register	Address:	0x2BH			
(EnergyD	))						
	Bit23	22	21	20 3	2	1	Bit0
Read:	EP23	EP22	EP21	EP20EP3	EP2	EP1	EP0

EnergyD 寄存器是累加型自定义能量寄存器。当选择为累加型时(EMUCON 寄存器bit15=0),在 0xFFFFFF 溢出到 0x000000 时,会产生溢出标志 QOIF(参见 IF 0x41H)。当选择为清零型时(EMUCON 寄存器 bit15=1),寄存器读后清为 0.

电能参数是无符号数, EnergyD 的寄存器值分别代表 QF 脉冲的累加个数。寄存器最小单位代表的能量为 1/EC kVARh。其中 EC 为电表常数。

EnergyD 默认是无功电能寄存器。可通过 EMUCON2 寄存器进行配置。

#### 自定义电能寄存器 2

UserDEFINE	Energy	Register2	Address:	0x2CH
(EnergyD2)				



	Bit23	22	21	20 3	2	1	Bit0
Read:	EP23_2	EP22_2	EP21_2	EP20_2EP3_2	EP2_2	EP1_2	EP0_2

当计量控制寄存器 2 的 energy\_fz 位等于 0 时,该寄存器是读后清零型自定义电能寄存器; 当计量控制寄存器 2 的 energy\_fz 位等于 1 时,该寄存器启用定时冻结功能,每隔 572.1793 毫秒(2048 个晶振周期)将自定义电能寄存器(地址 2B)的值装载到该寄存器,同时将自定义电能寄存器清零。

#### 计量状态寄存器

此寄存器包括计量状态寄存器和校验和寄存器两部分。

EMU S	TATUS Register	(EMUStatus) Address: 0x2D 只读寄存器
位	位名称	功能描述
23	保留	只读为0
		只读寄存器,表征 VREF 工作状态。
22	VREFLOW	=1,表示 REFV 引脚的电压值过低,外部电路有异常;
		=0,表示 REFV 引脚的电压值没有出现过低现象。
21	保留	只读为0
20	Noqld	当自定义功率小于起动功率时,NoPld 被置为1;当自定义功率大于
20	rvoqiu	/等于起动功率时 NoPLd 清为 0。
19	19 Nopld	当有功功率小于起动功率时, NoPld 被置为 1; 当有功功率大于/等
19	Nopid	于起动功率时 NoPLd 清为 0。
18	REVQ	反向自定义功率指示标识信号, 当检测到负功率时, 该信号为 1。
10	REVQ	当再次检测到正功率时,该信号为 0。在 QF 发脉冲时更新该值。
17	REVP	反向有功功率指示标识信号,当检测到负有功功率时,该信号为1。
17	KLVI	当再次检测到正有功功率时,该信号为0。在PF发脉冲时更新该值。
		校表数据校验计算状态寄存器。
16	ChksumBusy	ChksumBusy =0,表示校表数据校验和计算已经完成。校验值可用。
		ChksumBusy =1,表示校表数据校验和计算未完成。校验值不可用。
15:0	Chksum	校验和输出

EMUStatus [15:0]是 RN8207C 专门提供一个寄存器来存放校表参数配置寄存器的 16 位校验和,外部 MCU 可以检测这个寄存器来监控校表数据是否错乱。

校验和的算法为双字节累加后取反。对于单字节寄存器 PHSA/PHSB,将其扩展为双字节后累加,扩展的字节为 00H。

RN8207C 参与校验和计算的寄存器地址是 00H-17H, RN8207C 的校验和默认值为: 0xD879。

以下三种情况下,重新开始一次校验和计算:系统复位、00H-17H 某个寄存器发生写操作、EMUStatus 寄存器发生读操作。一次校验和计算需要 11.2us。

#### 过零计数寄存器

地址: 34H; 字长: 2字节



当软件使用过零测量特殊命令(0xEA/0x&7C,见 2.12.6 章节)时,计量芯片将收到该命令的时刻作为时间基准,测量出电压过零与该时间基准的时间差,时间差保存在 ZXCNT(0x34H)寄存器。当用户使用三个 RN8207C 设计三相表时,通过 UART 的广播命令发送过零测量特殊命令,三个 RN827C 收到命令后同时启动测量,软件根据三个 RN8207C 测量值可实现三相电压相序的判断。

该寄存器存放的是时间基准与真实电压过零的时间计数值,最小单位是 256 个晶振周期,即 71.517 微秒(当晶振为 3.579545MHz 时)。启动特殊命令后一个周波完成测量,在下次特殊命令发出前,测量值一直不变。

#### 2.12.4 中断寄存器

#### 中断配置和允许寄存器

当中断允许位配置为1且中断产生时,IRQ\_N引脚输出低电平。写保护寄存器,配置该寄存器前需将写使能打开。

Intern	rupt Enable	Register (IE) Address: 0x40H 默认值: 0x00H 可读可写
位	位名称	功能描述
7	保留	保留,读出为0
6	FZIE	FZIE=0: 关闭电能冻结中断; =1: 使能电能冻结中断
5	ZXIE	ZXIE=0: 关闭过零中断; ZXIE=1: 使能过零中断。
4	QEOIE	QEOIE=0: 关闭自定义电能寄存器溢出中断;
4	QEOIE	QEOIE=1: 使能自定义电能寄存器溢出中断。
3	PEOIE	PEOIE=0: 关闭有功电能寄存器溢出中断;
3	TEOIL	PEOIE=1: 使能有功电能寄存器溢出中断。
2	QFIE	QFIE=0: 关闭QF中断; QFIE=1: 打开QF中断。
1	PFIE	PFIE=0: 关闭PF中断; PFIE=1: 打开PF中断。
		DUPDIE=0: 关闭数据更新中断; DUPDIE=1: 使能数据更新中断。
0	DUPDIE	数据 PowerPA/PowerPB、IARMS/IBRMS、URMS 寄存器刷新的频率为
		3.495Hz 或 13.982Hz, 当上述数据更新时,IRQ_N 引脚输出低电平。

#### 中断状态寄存器

Interr	upt Flag Re	gister (IF) Address: 0x41H 只读					
位	位名称	功能描述					
7	Reserved	保留,读出为0					
6	FZIF	FZIF=0: 未发生电能冻结事件; =1: 发生过电能冻结事件					
5	ZXIF	ZXIF =0: 未发生过零事件; ZXIF =1: 发生过零事件。					
4	OEOIE	QEOIF=0: 未发生自定义电能寄存器溢出事件;					
4	4 QEOIF QEOIF=1: 发生自定义电能寄存器溢出事件。						
3	PEOIF	PEOIF=0: 未发生有功电能寄存器溢出事件;					
		PEOIF=1: 发生有功电能寄存器溢出事件。					



2	QFIF	QFIF=0: 未发生 QF 脉冲输出事件;
		QFIF=1: 发生 QF 脉冲输出事件。
1 DETE		PFIF =0: 未发生 PF 脉冲输出事件;
1	PFIF	PFIF =1: 发生 PF 脉冲输出事件。
0	DUDDIE	DUPDIF=0: 未发生数据更新事件;
0	DUPDIF	DUPDIF=1: 发生数据更新事件。

IF 适用于 SPI 和 UART 接口。当某中断事件产生时,硬件会将相应的中断标志置 1。 IF 中断标志的产生不受中断允许寄存器 IE 的控制,只由中断事件是否发生决定。 IF 为只读寄存器,读后清零。

#### 复位中断状态寄存器

Reset Into	Reset Interrupt Flag Register (RIF )			0x42H				
	Bit7	6	5	4	3	2	1	Bit0
Read:	0	FZIF	RZXIF	RQEOIF	RPEOIF	RQFIF	RPFIF	RDUPDIF

该寄存器功能等同 IF。

#### 2.12.5 系统状态寄存器

#### 系统状态寄存器

Syster	n Status Regi	ister (SysStatus) Address: 0x43H 只读					
位	位名称	功能描述					
7-5	Reserved	只读,读出为0.					
4	WREN	写使能标志: =1 允许写入带写保护的寄存器;					
4	WKEN	=0 不允许写入带写保护的寄存器					
3	A1	表征串行通信类型和地址选择引脚 A1 的状态,只读。					
2	A0	表征串行通信类型和地址选择引脚 A0 的状态,只读。					
1	1 GOFFREE 命令复位标志。当命令复位结束时,该位置 1。读后清零。可用于复位						
1	SOFTRST	校表数据请求。					
0	рст	硬件复位标志。当外部 RST_N 引脚或者上电复位结束时,该位置 1。读					
U	RST	后清零。可用于复位后校表数据请求。					

#### UART 读校验寄存器

RData(0x44H)寄存器保存前次 UART 读出的数据,可用于 UART 读出数据时的校验。

#### UART 写校验寄存器

WData(0x45H)寄存器保存前次 UART 写入的数据,可用于 UART 写入数据时的校验。



### 2.12.6 特殊命令

命令名称	命令寄存器	数据	描述
写使能命令	0xEA	0xE5	使能写操作
写保护命令	0xEA	0xDC	关闭写操作
复位命令	0xEA	0xFA	复位命令,等效于外部 PIN 复位;当写使能之后,系统才接受该命令; 建议客户 CPU 对计量初始化前先进行软件复位或者PIN 复位;
过零测量命令	0xEA	0X7C	当软件使用过零测量特殊命令时,计量芯片将收到该命令的时刻作为时间基准,测量出电压过零与该时间基准的时间差,时间差保存在 ZXCNT(0x34H)寄存器。当用户使用三个 RN8207C 设计三相表时,通过 UART 的广播命令发送过零测量特殊命令,三个 RN827C 收到命令后同时启动测量,软件根据三个 RN8207C 测量值可实现三相电压相序的判断。

### 写保护的范围:

0x00h-0x17h 校表参数配置寄存器、0x20h-0x21h 快速脉冲寄存器、0x40h 中断允许寄存器,用特殊命令写使能后才能写入修改,具体命令格式如上表。



### 3 校表方法

RN8207C 提供了丰富的校正手段实现软件校表,经过校正的仪表,有功和无功精度均可达 0.5S 级。RN8207C 的校正手段包括:

- 电表常数(HFConst)可调
- 提供增益校正
- 提供相位校正
- 提供有功、无功和有效值 offset 校正
- 提供无功相位补偿
- 提供小信号加速校正功能
- 提供校表数据自动校验功能

具体校表方法参见《锐能微第三代单相计量芯片应用笔记》。



### 4 通信接口

- 支持 UART 接口,工作在从模式、半双工通讯、9 位 UART (含偶校验位)
- 支持多从机通讯模式,通过硬件管脚配置从机片选地址: 0/1/2 三档可选
- 波特率固定为 4800
- 支持单播/广播两种通信方式
- 帧结构包含 CHIPID 字节和校验和字节,安全可靠

### 4.1 UART 接口信号说明

TX: UART 从机 (RN8207C) 数据发送管脚; RX: UART 从机 (RN8207C) 数据接收管脚:

B1/B0: 波特率选择管脚,用于配置 RN8207C UART 波特率,B1/B0 不同的配置会导致系统控制寄存器 SYSCON[14:8]的值不同,对应关系如下图所示:

A1/A0: 片选地址配置管脚,注意 A1/A0 不能等于 11,当 A1/A0 不等于 11 时,用于配置当前 RN8207C 芯片的片选地址 CID[1:0]; A1/A0 的值也映射在系统状态寄存器 SysStauts[3:2]中。

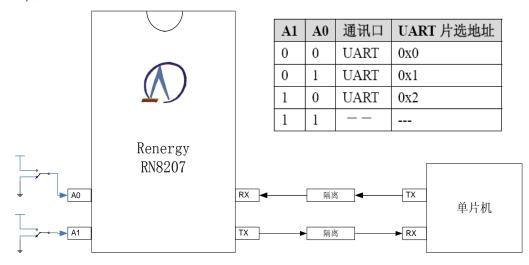


图 4-1 UART 典型接线图

### 4.2 UART 多从机通讯

RN8207C UART 支持多从机总线通信模式,总线上最多可支持三个从机(RN8207C)与 主机(单片机)通讯,RN8207C 通过 A1/A0 配置成不同的片选地址,单片机根据片选地址区分不同的从机(RN8207C)芯片;典型应用如图 4-2 所示:



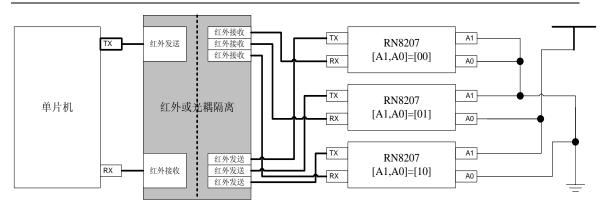


图 4-2 UART 多从机通讯示意图

### 4.3 UART 数据字节格式

UART 为 9 位异步通信口,发送、接收一个字节信息由 11 位组成,即起始位(StartBit,

- 0)、数据位(低位在先)、1位偶校验位(Parity Bit, 第9数据位)和1位停止位(Stop Bit,
- 1)。如下图所示:

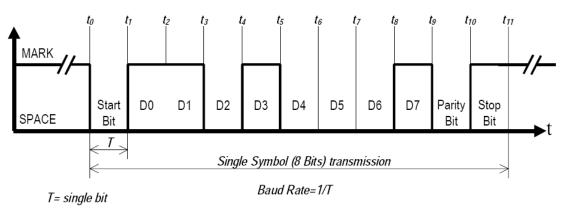


图 4-6 UART 数据字节格式

### 4.4 UART 帧格式

CHIPID	CMD	DATA	 DATA	CKSUM
		最高有效字节	最低有效字节	

RN8207C UART 通讯帧格式如下图和表格所示:

名称	解释
CHIPID	片选地址字节,由主机端发送;
	ChipID[7:6]=ChipID[3:2]=[10];



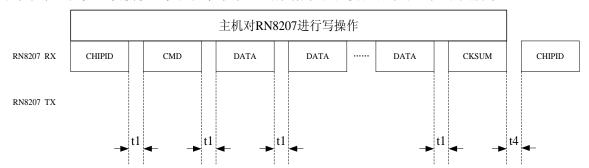
	ChipID[5:4]=ChipID[1:0]=片选地址 CID[1:0]
	与主机端发送的片选地址匹配的 RN8207C 器件将接受后面的命令
	若主机发送的片选地址为11,表示广播地址,如果是写命令,那么写操作对总线上
	所有的从器件都有效;如果是读命令,命令无效,所有的从器件都不做任何反馈。
CMD	命令字节,由主机端发送,
	CMD[7]: 表示命令类别; 0, 读操作, 1: 写操作;
	CMD[6:0]: 表示被选中 RN8207C 器件的内部寄存器地址
	若 CMD[7]=1, 而 CMD[6:0]=0x6A,表示本次操作是特殊命令;
DATA	数据字节;读操作由从机端发送,写操作由主机端发送
	若寄存器地址对应寄存器是多字节寄存器,先传最高有效字节;
CKSM	校验和字节, 读操作由从机端发送, 写操作由主机端发送
	校验和算法如下:
	CheckSum[7:0] = $\sim$ (ChipID+CMD[7:0] + DATAn[7:0] + +DATA1[7:0])
	即将 CMD 和数据相加,抛弃进位,最后的结果按位取反;

命令名称	片选地址字节	命令字节	数据字 节	描述
读命令	{10,CID[1:0], 10,CID[1:0]}	{0,REG_ADR[6:0]}	RDATA	从 片 选 地 址 为 CID [1:0] 的 RN8207C 器 件 中 的 地 址 为 REG_ADR[6:0]的寄存器读数据。 注意: 读无效地址,返回值为 00h。
写命令	{10,CID[1:0], 10,CID[1:0]}	{1,REG_ADR[6:0]}	WDATA	若 CID[1:0]!=0x3: 向片选地址为 CID[1:0]的 RN8207C器件中的地址为 REG_ADR[6:0]的寄存器写数据。 若 CID[1:0]=0x3: 向所有的从机中的地址为 REG_ADR[6:0]的寄存器写数据。
写使能命令	{10,CID[1:0], 10,CID[1:0]}	0xEA	0xE5	若 CID[1:0]!=0x3,命令针对地址 匹配的 RN8207C 器件
写保护命令	{10,CID[1:0], 10,CID[1:0]}	0xEA	0xDC	若 CID[1:0]=0x3, 命令针对总线上 所有的 RN8207C 器件 命令描述"参见 2.12.6 特殊命令章 节。"
软件复位命令	{10,CID[1:0], 10,CID[1:0]}	0xEA	0xFA	软件复位命令,等效于外部 PIN 复位;当写使能之后,系统才接受该命令; 建议客户 CPU 对计量初始化前先进行软件复位或者 PIN 复位;



### 4.5 UART 写操作

写操作由主机端发起,主机端先发送片选地址字节,总线上的 RN8207C 器件均接收片选地址字节;被选中的 RN8207C 器件会进命令接收状态;接收主机随后发送的命令字节,如果是写命令,从机继续接收主机随后依次发送的数据字节和校验和字节。如下图所示:

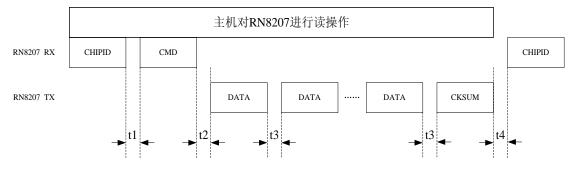


#### 注意事项:

- 1. 9位 UART, 字节信息由 11位组成,即起始位(0)、数据位(低位在先)、1位偶校验位(第9数据位)和1位停止位(1)。
- 2. 字节发送端计算并发送校验位,字节接收端根据校验位判断字节传送是否有效;如果字节错误,随后的字节被认为是新的帧的开始;
- 3. 多字节寄存器,先传输高字节内容,再传输低字节内容;
- 4. 主机发送字节之间的时间 t1,由主机端控制,RN8207C 没有限制,t1 大于等于 0ns;
- 5. 帧之间的时间 t4,由主机端控制,RN8207C 没有限制,t4 大于等于 0ns;
- 6. 有写保护功能的寄存器在写操作之前要先写入写使能命令。
- 7. 主机计算并发送校验和,从机根据校验和判断帧传送是否成功

### 4.6 UART 读操作

读操作由主机端发起,主机端先发送片选地址字节,总线上的 RN8207C 器件均接收片选地址字节;被选中的 RN8207C 器件会进命令接收状态;接收主机随后发送的命令字节,如果是读命令,RN8207C 随后由 TX 发送读数据字节、读校验和字节。如下图所示:



#### 注意事项:

1. 9位 UART,字节信息由 11位组成,即起始位(0)、数据位(低位在先)、1位偶校



验位(第9数据位)和1位停止位(1)。

- 2. 字节发送端计算并发送校验位,字节接收端根据校验位判断字节传送是否有效;如果字节校验错误,字节接收端认为当前帧错误并结束;
- 3. 多字节寄存器, 先传输高字节内容, 再传输低字节内容;
- 4. 主机发送字节之间的时间 t1,由主机端控制,RN8207C 没有限制,t1 大于等于 0ns 即可:
- 5. 主机发送字节和从机发送字节之间的时间 t2,由从机控制,t2=T/2(T 是每比特的传送时间);
- 6. 从机发送字节之间的时间 t3, 由从机控制, t3=T(T 是每比特的传送时间);
- 7. 帧之间的时间间隔 t4,由主机端控制,RN8207C 没有限制,t4 大于等于 0ns 即可;
- 8. 主机计算并发送校验和,从机根据校验和判断帧传送是否成功

### 4.7 UART 接口可靠性设计

UART 接口可靠性设计包括以下方面:

- 硬件管脚配置波特率,安全可靠
- UART 数据字节传送具有位校验(偶校验)功能
- UART 通讯帧传输具有校验和功能
- 硬件管脚的配置的结果反映在寄存器中;
- 寄存器校验功能
  - 1. 提供校验寄存器 EMUStatus 用于存放内部校表寄存器的校验和。
  - 2. 提供读校验寄存器 RData, 保存前次读出的数据。
  - 3. 提供写校验寄存器 WData, 保存前次写入的数据。
- 写保护功能

对所有可读可写寄存器有写保护功能。



# 5 电气特性

<b>精度</b> (V <sub>dd</sub> =AV <sub>dd</sub> =5V±5%,室温)								
	符号	(V <sub>dd</sub> =A V 最小	<sub>dd</sub> =3 v ±3/ 典型	。, 至価) <b>最大</b>	单位	测试条件和注释		
有功电能测量误差	Err	72.7		$\pm 0.1\%$	1 12	常温8000:1的动态范围		
有功电能测量带宽	BW		7		kHz	OSCI=3.579545MHz		
无功电能测量误差	Err			±0.1%		常温8000:1的动态范围		
有效值测量误差	Err			±0.1%		常温1000:1的动态范围		
模拟输入								
最大信号电平	V <sub>xn</sub>			±1000	mV			
直流输入阻抗	$Z_{DC}$	300			kΩ			
ADC失调误差	$\mathrm{DC}_{\mathrm{off}}$		1		mV			
-3dB带宽	$B_{-3dB}$		7		kHz	OSCI=3.579545MHz		
			基准电压					
	$(V_{dd} = AV_{dd})$	=5V±5%	,温度范	围: -40℃~	√+85°C)			
输出电压	$V_{ref}$		1.25		V			
温度系数	T <sub>c</sub>		5	15	ppm/℃			
输入阻抗			4		kΩ			
			时钟输入					
输入时钟频率范围	OSCI	1	3.58	4	MHz			
		数字	输入输出	接口				
UART接口速率			4800		Hz			
RSTN、A0、A1 输入高	<b>T</b> 7	0.7*		DV	V	$DV_{dd} = 5V$ , $-40-85$ °C		
电平	$V_{IH}$	vdd		$\mathrm{DV}_{\mathrm{DD}}$	V			
RSTN、A0、A1输入低电				0.3*		DV <sub>dd</sub> =5V, -40-85°C		
平	$V_{IL}$	DGND		Vdd	V	du		
RX输入高电平	V <sub>IH</sub>	2. 5		$\mathrm{DV}_{\mathrm{DD}}$	V	DV <sub>dd</sub> =5V, -40-85°C		
RX输入低电平	$V_{\rm IL}$	DGND		1.7	V	DV <sub>dd</sub> =5V, -40-85℃		
/A 1: 1 ==						DV <sub>dd</sub> =5V, 室温;		
IRQN/ZX 输出高电平	$V_{OH}$	4		$\mathrm{DV}_{\mathrm{DD}}$	V	Isource=3.5mA		
						DV <sub>dd</sub> =5V, 室温;		
IRQN/ZX 输出低电平	$V_{OL}$			0.5	V	Isink=8mA		
						DV <sub>dd</sub> =5V,室温;		
PF、TX输出高电平	$V_{OH}$	4		$DV_{DD}$	V	Isource=5mA		
PF、TX输出低电平	V <sub>OL</sub>	DGND		0.5	V	DV <sub>dd</sub> =5V,室温		
			. 1 . ১			Isink=12mA		
	4	1 4 5	电源	1	* 7	#\$7 .400/		
模拟电源	$AV_{DD}$	4.5		5.5	V	<b>5V</b> ±10% 或3.3V±10%		
数字电源	$\mathrm{DV}_{\mathrm{DD}}$	4.5		5.5	V	5V±10%		
—————————————————————————————————————	D Λ DD	7.3		3.3	· •	J ¥ ±10/0		

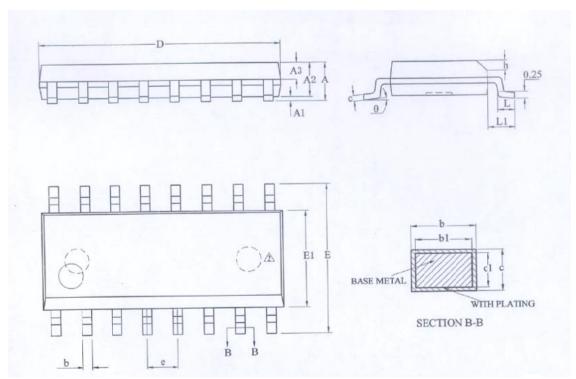


#### 单相多功能防窃电专用计量芯片 RN8207C

	•		1	1		
						或3.3V±10%
模拟电流	AIdd1		1.5		mA	
数字电流	DIdd		1.3		mA	OSCI=3.579545MHz
			极限参数			
数字电源电压	$DV_{DD}$	-0.3		+7	V	
模拟电源电压	$AV_{DD}$	-0.3		+7	V	
DV <sub>DD</sub> to DGND		-0.3		+7	V	
DV <sub>DD</sub> to AV <sub>DD</sub>		-0.3		+0.3	V	
V1P,V1N,V2P,V2N		-6		+6	V	
数字输入电压相对于	$V_{IND}$	-0.3		$\mathrm{DV}_{\mathrm{DD}}$	V	
GND				+0.3	v	
数字输出电压相对于	$V_{outD}$	-0.3		$\mathrm{DV}_{\mathrm{DD}}$	V	
GND				+0.3	V	
模拟输入电压相对于	V <sub>INA</sub>	-0.3		$AV_{DD}$	V	
AGND				+0.3	v	
工作温度范围	$T_A$	-40		85	$^{\circ}$ C	
存储温度范围	$T_{stg}$	-65		150	$^{\circ}$ C	



# 6 芯片封装



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A			1.75
A1	0.05		0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.6	0.65	0.70
b	0.39		0.48
b1	0.38	0.41	0.43
С	0.21		0.26
c1	0.19	0.20	0.21
D	9.70	9.90	10.10
Е	5.80	6.00	6.20
E1	3.70	3.90	4.10
e	1.27BSC		
h	0.25		0.5
L	0. 5		0.8
L1	1.05BSC		
θ	0		8°